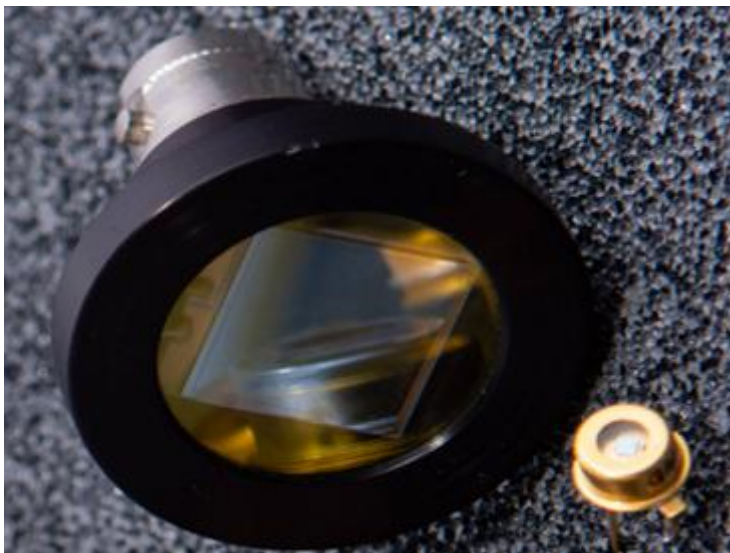


10mm Ge 大光敏面探测器（BNC 接口输出）



产品描述

锗光电二极管通常用于测量近红外范围内的光功率，尤其是在成本敏感型应用或需要大面积探测器的应用中。然而，与类似尺寸的 InGaAs 探测器相比，锗探测器的分流电阻较低，暗电流较高，导致整体噪声水平较高。因此，锗探测器非常适合检测信号远高于本底噪声的应用。筱晓光子提供“HS”系列锗光电二极管，其分流电阻高于典型值，可提高性能。

产品特点

芯片直径从 1 毫米到 25 毫米、光谱响应从 800 nm 到 1700 nm、多种窗口和镜头选项、可用的光学滤波器（中性密度、带通等）、热电冷却选项、多种封装类型：TO 封装、BNC 选项、陶瓷基座上的芯片等

产品型号

GE-10X10-BNC

应用领域

光功率测量

光谱学

光学测试

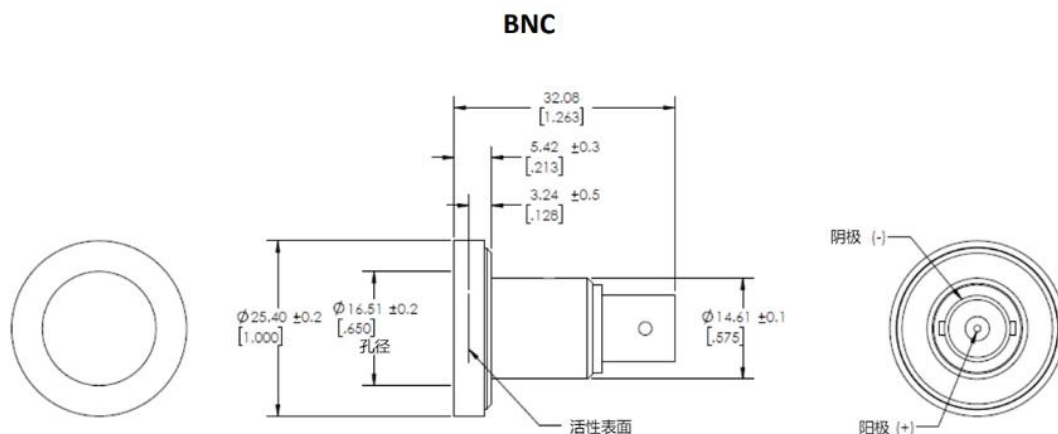
医疗诊断

光纤接收器

核心参数

光谱响应范围	光敏面直径	响应度
800-1700nm	10mm	@1550nm 0.85 A/W

尺寸图



详细参数

10X10mm 锗光电二极管性能规格				
型号	GB10M-XX	GE-10X10-BNC	GV10M-XX	
光电特性@ 23 °C ± 2 °C				单位
R _{SHUNT} @ 10mV (Min. /典型)	联系我们	2/3.5	联系我们	kΩ
I _{DARK} (Max.)		50		μA
电容 (Max.)		90000		pF
V _{REVERSE}		0.5		V
噪声等效功率 (典型)		6		pW/Hz ^{1/2}
Max. 反向电压		1		V

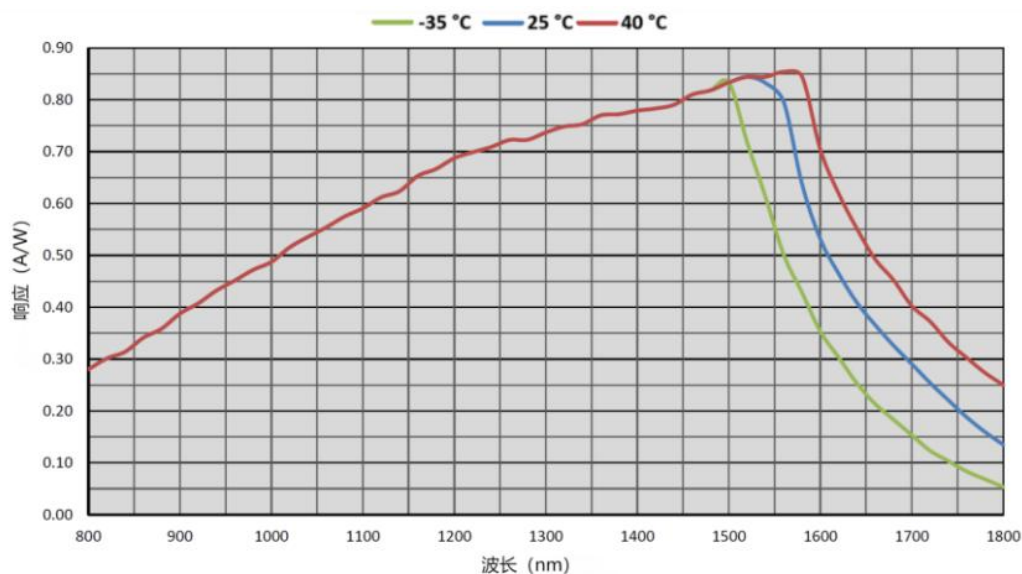
锗光电二极管

光电特性 @ 23 °C ± 2 °C

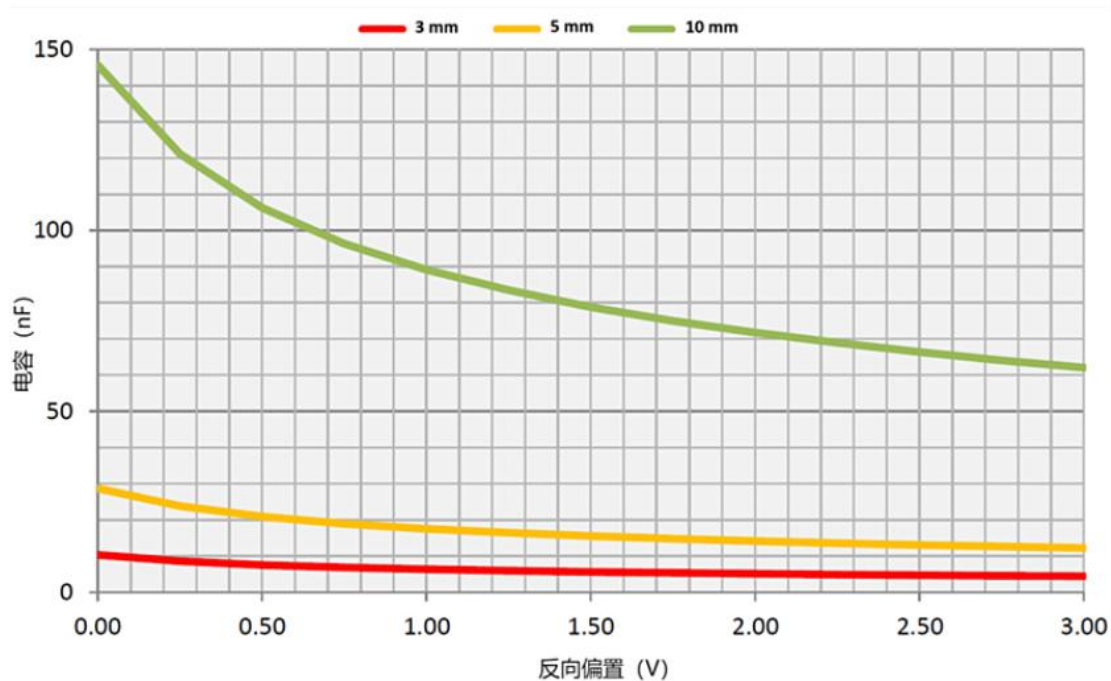
光谱响应范围	800-1700	nm
响应度@850 nm (典型值)	0.30	A/W
响应度@1300 nm (典型值)	0.75	A/W
响应度@1550 nm (典型值)	0.85	A/W
线性度	10	dBm
存储温度	-40 to 125	°C
工作温度	-40 to 85	°C
Max. 额定值 @ 23 °C ± 2 °C		
反向电流	20	mA
正向电流	10	mA

特性曲线

不同温度波长响应曲线:



电容偏置电压曲线:



订购信息

型号: GE-10X10-BNC